

Doç.Dr. Abdulkadir Korkut

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 505 444 5065](tel:+905054445065) Dahili: 27857

İş Telefonu: [+90 432 444 5065](tel:+904324445065) Dahili: 27805

E-posta: akkut@yyu.edu.tr

Web: <https://avesis.yyu.edu.tr/akkut>

Posta Adresi: YYÜ Fen Fakültesi Fizik Bl Tuşba 65080 VAN

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ScholarID: IcdKZrIAAAAJ

ORCID: 0000-0003-0100-4057

Publons / Web Of Science ResearcherID: R-1778-2018

Yoksis Araştırmacı ID: 158062

Eğitim Bilgileri

Doktora, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Türkiye 2009 - 2015

Yüksek Lisans, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fizik, Türkiye 1996 - 1999

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, TEMİZ HAVA ORTAMINA MARUZ BIRAKILMIŞ n-Si VE n-GaP YARIİLETKENLERDEN ÜRETİLMİŞ SCHOTTKY DİYOTLARIN KARAKTERİSTİKLERİNE ARAYÜZEY OKSİT TABAKA KALINLIĞININ ETKİSİ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), 2015

Yüksek Lisans, ÖLÇÜYE GÖRE KUANTLANMANIN ELEKTRON GAZININ BAZI TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), 1999

Araştırma Alanları

Fizik

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2005 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Termoelektrik I, Yüksek Lisans, 2021 - 2022

Sensors' Physics I, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Genel Fizik II, Lisans, 2017 - 2018
Genel Fizik I, Ön Lisans, 2018 - 2019
Kathal Elektronik I, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Genel Fizik I, Lisans, 2018 - 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **A NEW APPROXIMATION: FROM BARRIER LOWERING TO INTERFACE STATE DENSITY**
Korkut A.
Surface Review And Letters, cilt.28, sa.12, ss.21501251-21501252, 2021 (SCI-Expanded)
- II. **Interface controlling study of silicon based Schottky diode by organic layer**
İmer A. G., Korkut A., Farooq W. A., Dere A., Atif M., Hanif A., Karabulut A.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.30, ss.19239-19246, 2019 (SCI-Expanded)
- III. **New serial resistance equations: Derivated from Cheungs' functions for the forward and reverse bias I**
Korkut A.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.197, ss.45-52, 2018 (SCI-Expanded)
- IV. **DIFFERENTIAL DEPLETION CAPACITANCE APPROXIMATION ANALYSIS UNDER DC VOLTAGE FOR AIR-EXPOSED Cu/n-Si SCHOTTKY DIODES**
Korkut A.
SURFACE REVIEW AND LETTERS, cilt.25, 2018 (SCI-Expanded)
- V. **Yarıiletkeni Işıklı Etkileşen Pd/n-GaP Schottky Diyotun Elektriksel Sığa Değişimi Üzerine**
Korkut A., İmer Gencer A., İmer A. G.
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.1-6, 2017 (SCI-Expanded)
- VI. **The Effect of Air-Exposed Layer on Electrical Properties of Cu/n-Si/Al Schottky Diodes**
Korkut A., Bati B.
INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.5, ss.1-9, 2016 (SSCI)
- VII. **EFFECT ON HEAT CAPACITY OF DEGENERATED ELECTRON GAS IN DIMENSIONALLY QUANTIZED THIN FILMS**
Korkut A., Eminbeyli R.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, cilt.22, ss.4243-4249, 2008 (SCI-Expanded)
- VIII. **The Effect Of Quantizing Magnetic Field On Cyclotron Energy And Cyclotron Effective Mass In Size Quantized Films With Non-Parabolic Energy Band**
Korkut A.
Chinese Physics Letters, cilt.24, sa.9, ss.2639-2641, 2007 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Değişik Omik Kontak Sıcaklıklarında Tavlanmış Schottky Diyotların Fark Arınma Yük Yoğunluğu Yaklaşımı**
Korkut A.
GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.33, sa.2, ss.525-539, 2020 (ESCI)
- II. **On differential depletion length of Schottky diodes with copper-nickel alloy metal of front contact**
Korkut A.
TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, cilt.42, ss.587-599, 2018 (ESCI)
- III. **Effect of Illumination on the Photovoltaic Parameters of Al/p-Si Diode with an Organic Interlayer Prepared by Spin Coating Method**
İmer Gencer A., Tombak A., Korkut A.

Süleyman Demirel Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.20, ss.1-5, 2017 (Hakemli Dergi)

IV. The Change of Series Resistance and Conductance-Voltage-Frequency Characteristics of Cu/N-Si Schottky Diode Exposed To Air

Korkut A., Bati B.

Journal of Nanotechnology & Advanced Materials, cilt.5, sa.2, ss.49-55, 2016 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

I. HYBRID DEVICE BASED ON NANOSTRUCTURED ZnO FILM DOPED WITH GRAPHENE OXIDE

İmer A. G., Korkut A.

International Research in Engineering Sciences III, Mehmet Kamanlı, Editör, Eğitim yayınevi, Konya, ss.21-36, 2022

II. HYBRID DEVICE BASED ON NANOSTRUCTURED ZnO FILM DOPED WITH GRAPHENE OXIDE

GENÇER İMER A., KORKUT A.

International Research İn Engineering Sciences III, Mehmet Kamanlı, Editör, Eğitim yayınevi, Konya, ss.21-36, 2022

III. ABOUT A NEW INTERFACE STATE DENSITY APPROXIMATION: BASED ON TRADITIONAL METHODS FOR N-TYPE ORGANIC SCHOTTKY DIODES

Korkut A., Gencer-İmer A. G.

Matematik ve Fen Alanında Uluslararası Araştırmalar II (Mart 2021), Dr. Öğr. Üyesi Nevin AKDURA, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.98-137, 2021

IV. ABOUT A NEW INTERFACE STATE DENSITY APPROXIMATION: BASED ON TRADITIONAL METHODS FOR N-TYPE ORGANIC SCHOTTKY DIODES

KORKUT A., GENÇER İMER A.

MATEMATİK VE FEN ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II, Nevin AKDURA, Editör, eğitim yayınevi, İstanbul, ss.99-138, 2021

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I. The investigation of the fundamental electrical parameters of Ag/n-Si hybrid structure based on functional organic dye

Mahmood O. H., İmer A. G., Ugur A., Korkut A.

2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD), Ardahan, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2018, cilt.46, ss.6966-6970

II. Ab-initio Study of Physical Properties of TbMn2O6

Aycibin M., İmer A. G., Korkut A.

2ND INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.131-135

III. Ab-initio study on Electronic structure of LaMn2X (X=Ge, Si)

Aycibin M., Korkut A.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.134

IV. About Depletion Time Constant of Differential Depletion Region: when the Paralel Magnetic Field Applied to İnterface of Shottky Diode

Korkut A., İmer A. G., Aycibin M.

4th International Conference on Advance in Natural & Applied Science chemistry (ICANAS 2019), Ağrı, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019, ss.32-36

V. A Comparison Differential Depletion Length by Debye Length for Schottky Diode under the Incident Light

Korkut A., Aycibin M.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ankara, Türkiye, 19 - 22

Haziran 2019, ss.136

VI. SCHOTTKY DİYOTLARIN SERİ DİRENCİNİN BAZI YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Korkut A., İmer A. G.

1. ULUSLARARASI İĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2018, ss.1298-1305

VII. OPTİCAL PROPERTIES OF CsSi₃(x=1,Br,Cl)

Aycibin M., Korkut A.

1. ULUSLARARASI İĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2018, ss.1419-1423

VIII. p-Si/SnEklemin Elektriksel Parametrelerinin Fonksiyonel Boya İnce Film İle Kontrol Edilmesi

Korkut A., İmer A. G.

1. ULUSLARARASI İĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2018, ss.1306-1311

IX. FIRST PRINCIPLE STUDY of CaTa₂O₆ COMPOUND

Aycibin M., Korkut A.

1. ULUSLARARASI İĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2018, ss.1341-1345

X. A Hypothetical Approximation on the Serial Resistance of Schottky Diodes

Korkut A.

2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD2018), Ardahan, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2018, cilt-, ss.75

XI. The Comparative Study on the Electrical Parameters of Ag/n-Si and Hybrid structure based on Organic Interlayer

Mahmood O., İmer A. G., Korkut A.

international conference on physical chemistry and functional materials, Ardahan, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2018, cilt.1, ss.47-51

XII. What Does the Rectification Number (Coefficient) Explain To the Schottky Diode?

İmer A. G., Korkut A.

international conference on physical chemistry and functional materials, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, cilt.1, ss.129

XIII. On Differential of Barrier Height Drop (DBHD) The Schottky Effect of Metal/n-Si/Al Schottky Diodes

Korkut A.

INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM IETS'18 main theme "ENERGY AND PETROLEUM, Batman, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.53

XIV. Laterally Inhomogeneous Barrier Analysis of Al/p-Si Organic-Inorganic Heterojunction with Inserting TB Thin Film

İmer A. G., Korkut A., Ocak Y.

INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICES, Konya, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2017, ss.78

XV. On Analysis of Differential Depletion Resistance of Pd/N-GaP Schottky Diodes Under Incident Light Onto Semiconductor Surface

Korkut A.

International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD-2017), Konya, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2017, sa.3214, ss.18

XVI. The Effect of GO Doping on The Electrical Properties of the High Frequency Ag/GO: CdO/p-Si Devices

İmer A. G., Korkut A., Tombak A.

INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICES, Konya, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2017, ss.77

XVII. Why Doesn't Equal To One (=1) of Total Serial Resistance to Serial Resistance Obtained from Cheung I Equation Ratio

Korkut A., İmer Gencer A., İmer A. G.

International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD-2017), Konya, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2017, cilt.PP, sa.51, ss.68

XVIII. The Comparative Study on the Electrical Parameters of Sn/p-Si (MS) and Sn/C14H15N3/p-Si (MIS) Diodes

İmer A. G., Korkut A., Yakuphanoglu F., Dere A.

Nanoscience Nanotechnology for Next Generation (NanoNG2016), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.132

XIX. Behaviour of Electrical Capacitance and Depletion Layer of (Ag, Cu, Ni)/n-Si/Al Schottky Diodes by Ohmic Temperatures

Korkut A., İmer A. G.

2'nd International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, Kırşehir, Türkiye, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.57

XX. What Does the Rectification Number (Coefficient) Explain To the Schottky Diode?

İmer A. G., Korkut A.

international conference on physical chemistry and functional materials, Elazığ, Türkiye, 19 Haziran 2016 - 21 Haziran 2018, cilt.1, ss.129

XXI. Havaya Maruz Bırakılmış (Air-Exposed) Schottky Diyotların MS Kalınlığının Karakteristiklere Etkisi Üzerine

Korkut A.

IV.YÜKPOP Uluslararası Vakum Çalıştayı, Afyon, Türkiye, 28 - 30 Mart 2016, ss.18

XXII. Electrical and photoelectrical characteristic investigation of a new generation photodiode based on bromothymol blue dye

Gençer İmer A. G., Tombak A., Korkut A.

International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP2016), Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2016, cilt.707, ss.12012-12021

XXIII. Electrical Characteristic Parameters of an Organic-Inorganic Device Based on Dimethyl Yellow Dye

İmer A. G., karaduman o., Korkut A.

1st International Conference On Advanced Functional Material Technologies (AFMAT 2015), Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2015, ss.46-47

Desteklenen Projeler

Korkut A., İmer A. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı IV, III-V Yarıiletken MS, MSM, MIS, MIM, SIS Schottky Kontaktların Organik veya İnorganik Arayüzeylerinin Diyod Değişkenlerine Etkisi, 2018 - 2022

Bati B., Korkut A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Temiz Hava Ortamına Maruz Bırakılmış n-Si ve n-GaP Yarıiletkenlerden Üretilmiş Schottky Diyotların Karakteristiklerine Arayüzey Oksit Tabaka Kalınlığının Etkisi, 2014 - 2016

Metrikler

Yayın: 39

Atıf (WoS): 21

Atıf (Scopus): 27

H-İndeks (WoS): 3

H-İndeks (Scopus): 3

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

1. ULUSLARARASI İÇDİR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Katılımcı, Iğdır, Türkiye, 2018

2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD2018), Katılımcı, Ardahan, Türkiye, 2018

INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM IETS'18 main theme "ENERGY AND PETROLEUM,
Katılımcı, Batman, Türkiye, 2018

International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD-2017) Konya, Katılımcı, Konya, Türkiye, 2017

WITAM2016 (2nd) Kırşehir, Katılımcı, Kırşehir, Türkiye, 2016

VI.YUKPOP Afyon, Katılımcı, Afyon, Türkiye, 2016

Akademi Dışı Deneyim

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI